东沃电子
DOWOSEMI

# MB1S THRU MB10S

## Bridge Rectifier 桥式整流器

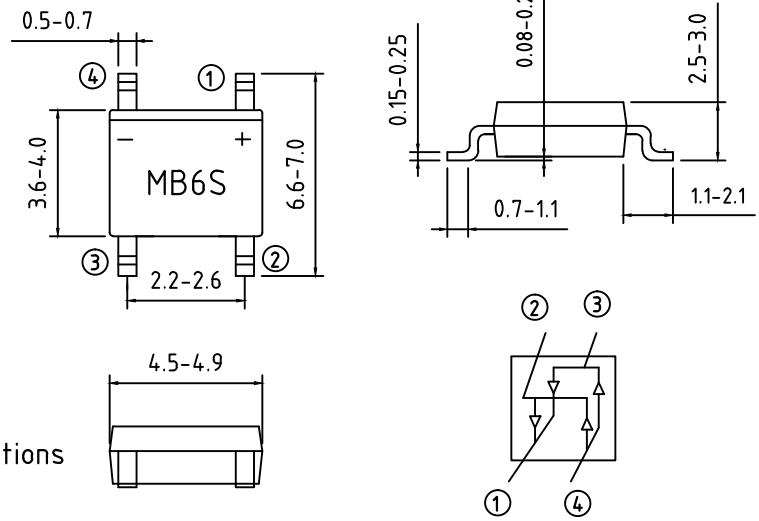
## ■ 特性 Features

- 玻璃钝化芯片
  Glass passivated chip
- 平均整流输出电流为1安培
  $I_o$ 0.8A
- 反向重复峰值电压为100至1000伏
  $V_{RRM}$ 100~1000V
- 耐正向浪涌电流能力高
  High surge forward current capability

## ■ 用途 Applications

- 作一般电源单相桥式整流之用
  General purpose 1 phase bridge rectifier applications

## ■ 外型尺寸和标记 Outline Dimensions and Mark




## ■ 极限值（绝对最大额定值）

Limiting values （Absolute Maximum Rating)

| 参数名称 Item | 符号 Symbol | 单位 Unit | 条件 Conditions | | MB 1S | 2S | 4S | 6S | 8S | 10S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反向重复峰值电压 Repetitive Peak Reverse Voltage | $V_{RRM}$ | V | | | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 平均整流输出电流 Average Rectified Output Current | $I_o$ | A | 60Hz正弦波电阻负载, Ta=25℃ 60Hz sine wave R-load, Ta=25℃ | 安装在氧化铝基板上 On alumina substrate | 0.8 | | | | | |
| | | | | 安装在玻璃-环氧基板上 On glass-epoxi substrate | 0.5 | | | | | |
| 正向(不重复)浪涌电流 Surge(Non-repetitive)Forward Current | $I_{FSM}$ | A | 60Hz正弦波, 一个周期, $T_j$=25℃ 60Hz sine wave, 1cycle , $T_j$=25℃ | | 30 | | | | | |
| 正向浪涌电流的平方对电流浪涌的持续时间的积分值 Current Squared Time | $I^2t$ | $A^2S$ | 1ms< t <8.3ms, $T_j$=25℃ .单个二极管 1ms< t <8.3ms , $T_j$=25℃ Rating of perdiode | | 3.7 | | | | | |
| 存储温度 Storage Temperature | $T_{stg}$ | ℃ | | | -55～+150 | | | | | |
| 结温 Junction Temperature | $T_j$ | ℃ | | | -55～+150 | | | | | |

## ■ 电特性（Ta=25 除非另有规定）

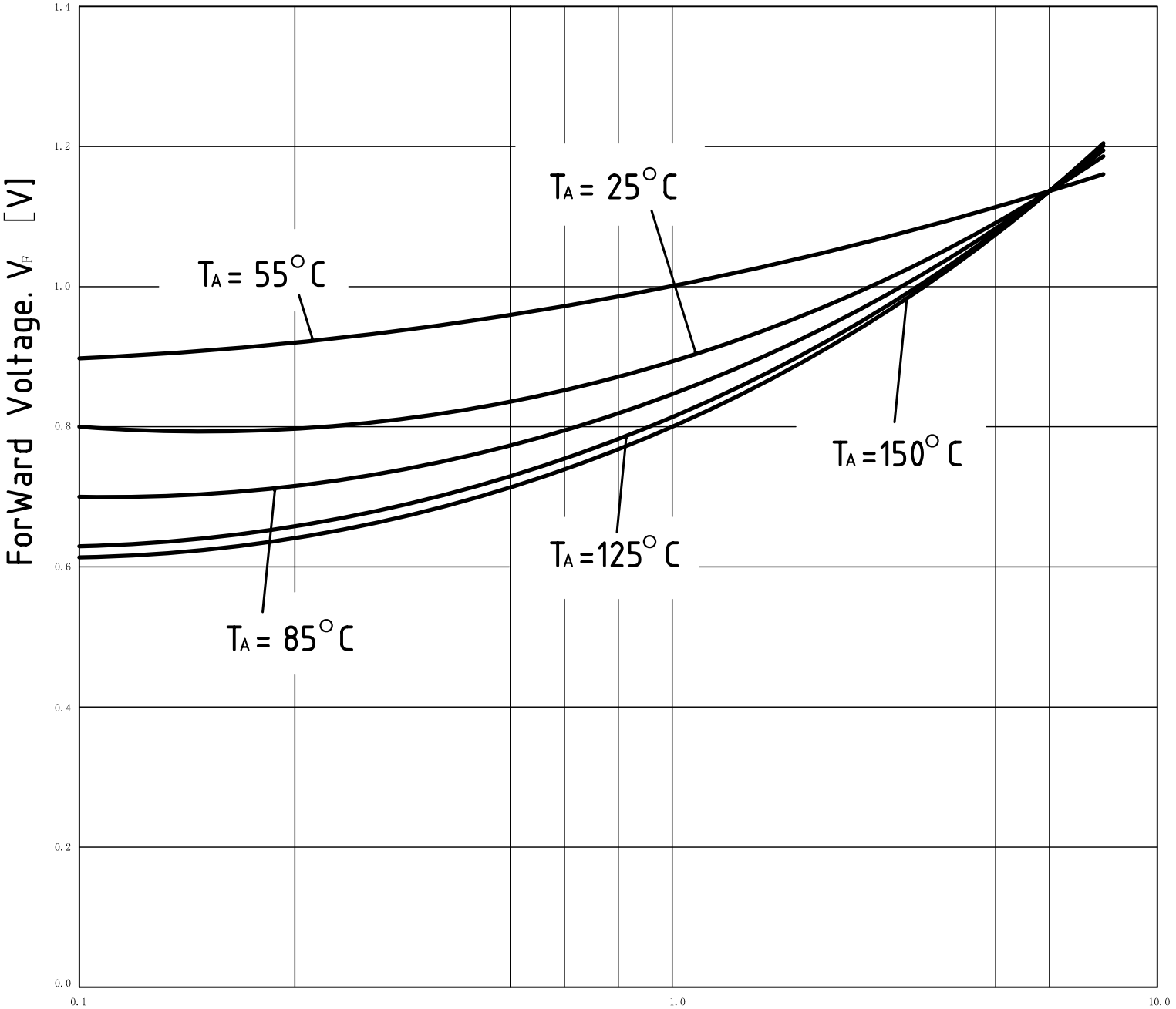
Limiting values （Absolute Maximum Rating)

| 参数名称 Item | 符号 Symbol | 单位 Unit | 测试条件 Test Condition | 最大值 Max |
|---|---|---|---|---|
| 正向峰值电压 Peak Forward Voltage | $V_{FM}$ | V | $I_{FM}$=0.4A, 脉冲测试, 单个二极管的额定值 $I_{FM}$=0.4A, pulse measurement Rating of per diode | 1.05 |
| 反向峰值电流 Peak Reverse Current | $I_{RRM}$ | μA | $V_{RM}$=$V_{RRM}$ 脉冲测试, 单个二极管的额定值 $V_{RM}$=$V_{RRM}$ pulse measurement Rating of per diode | 10 |
| 热阻 Thermal Resistance | $R_{\theta J-A}$ | ℃/W | 结和环境之间, 安装在氧化铝基板上 Between junction and ambient, on alumina substrate | 76 |
| | | | 结和环境之间, 安装在玻璃-环氧基板上 Between junction and ambient, on glass-epoxi substrate | 134 |
| | $R_{\theta J-L}$ | | 结和引线之间 Between junction and lead | 20 |

东沃电子
DOWOSEMI

# MB1S THRU MB10S

## 特性曲线（典型） Characteristics (Typical)



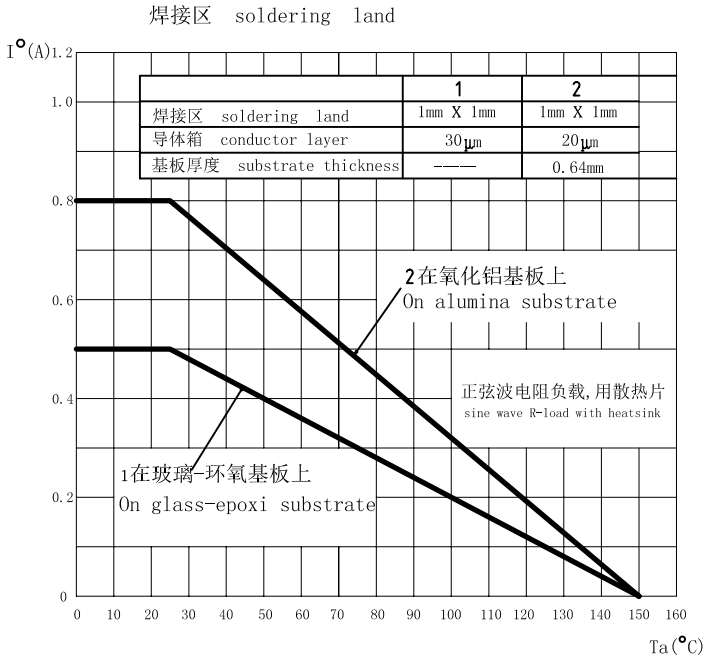

ForWard Voltage Vs Forward Current

东沃电子
DOWOSEMI

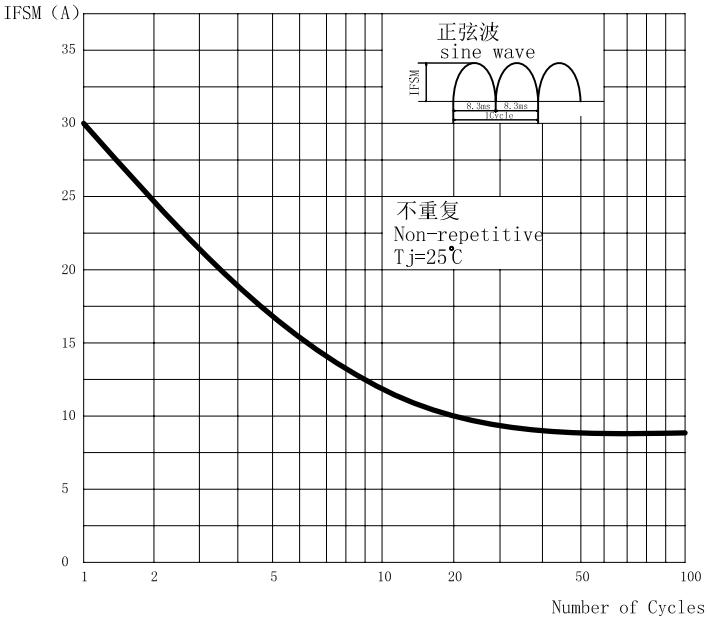
# MB1S THRU MB10S

## 特性曲线（典型） Characteristics (Typical)

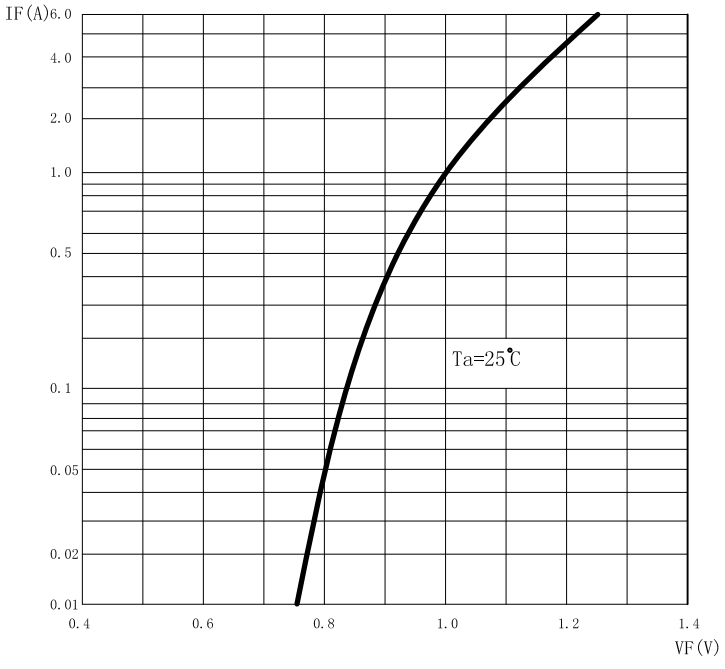
### 图1：$I_o$-Ta曲线
FIG: $I_o$-Ta curve




### 图2：耐正向浪涌电流曲线
FIG2: Surge Forward Current Capadility




### 图3:正向电压曲线
FIG3: Forward Voltage




### 图4:反向电流曲线
FIG4: Typical Reverse Characteristics